

# 2SA1388

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)

- 大電流高速スイッチング用
- DC-DC コンバータ用

通信工業用

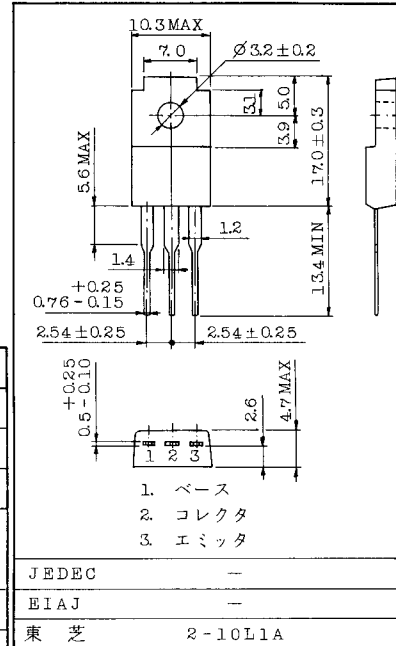
単位：mm

## 特長

- コレクタ飽和電圧が低い。  
：  $V_{CE(sat)} = -0.4V$  (最大) ( $I_C = -3A$ )
- スイッチング時間が速い。：  $t_{stg} = 1.0\mu s$  (標準)
- 2SC3540 とコンプリメンタリになります。
- 絶縁プッシング、マイカ等が不要な TO-220 相当のアイソレーションパッケージです。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-7	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	-5
	パルス	$I_{CP}$	-8
ベース電流	$I_B$	-1	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	$P_C$	2.0
	$T_c = 25^\circ C$		2.5
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	-	-	-1	$\mu A$
エミッタしゅ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -7V, I_C = 0$	-	-	-1	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-80	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -1V, I_C = -1A$	70	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -3A$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.15A$	-	-0.2	-0.4	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.15A$	-	-0.9	-1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	-	60	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	200	-	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	$t_{on}$	-	0.2	-	$\mu s$
	蓄積時間	$t_{stg}$	-	1.0	-	
	下降時間	$t_f$	-	0.1	-	

注：  $h_{FE(1)}$  分類 O : 70 ~ 140, Y : 120 ~ 240